

INDUSTRIE SERIES

WIG 251 HF ADi

DDA115.250.T-E.01.00

WIG 250 HF CDi

DDD115.250.T-E.02.02



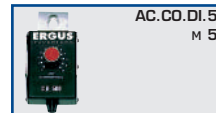
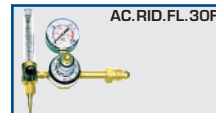
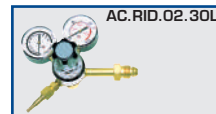
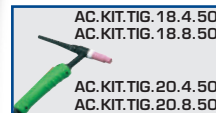
PROCESSI / ПРОЦЕССЫ

Ciclo di lavoro TIG DC • TIG DC режим работы	250 A – 70%
Corrente al 100 % • TIG DC ток при 100%	210 A
Ciclo di lavoro elettrodo • Реж. раб. при сварке эл-ом	250 A – 60%
Corrente al 100 % • Ток при 100%	195 A

INVERTER / ИНВЕРТОР

Tensione di alimentazione • Подача напряжения	3x400V-10+15%
Frequenza • Частота	50/60Hz
Tensione a vuoto • Напряжение холостого хода	85 V
Potenza nominale elettrodo 100% • Потр. мощн. при 100% MMA	6,8 KW
Potenza nominale TIG DC 100% • Потр. мощн. при 100% TIG DC	4,8 KW
Tensione d'arco elettrodo • Напре дуги при св-ке эл-ом	20,2 – 30,0 V
Tensione d'arco TIG • Напре дуги при TIG сварке	10,2 – 20,0 V
Corrente max • Максимальный ток	16 A
Fusibile di protezione • Плавкий предохранитель	time lag 16 A ritardato
Fattore di potenza • Коэффициент мощности	0,85
Grado di protezione • Степень защиты	IP 23 S
Classe d'isolamento • Класс изоляции	F
Temperatura ambiente • Рабочая температура	-10°C+40°C
Dimensioni (mm) • Габариты (мм)	400x180x225
Peso (Kg) • Вес (кг)	15,50

(3 GCE 180 CC a 30 1 280 Uctx&Ud&x0Sup&1 D



FUNZIONI / ФУНКЦИИ

Campo di regolazione elettrodo • Диапазон при эл-ой св-ке	5 – 250 A
Campo di regolazione TIG DC • Диапазон при св-ке TIG DC	5 – 250 A
Gорячий запуск • Горячий запуск	Automatic
Arc force • Сила дуги	selezionabile/on/off option
Anti incollaggio • Отсутствие прилипания	Automatic
Tipo innesco TIG DC • Тип поджига дуги	HF/LIFT ARC
Comando consenso TIG • Контроль TIG	2/4 T - STEP
Corrente di base • Базовый ток	min. ÷ 80%
Regolazione tempo di salita • Настройка времени	0-20sec
Regolazione tempo di discesa • Настр. реж. пад-я тока	0-20sec
Regolazione ritardo gas • Post gas	0-20sec
Corrente finale • Финальный ток	min. ÷ 80%
Pulser • Генератор импульсов	SI / YES
Frequenza Pulser • Частота ген-ра имп.	1-500 Hz / *1-400 Hz
*Ciclo attivo Pulser • Акт. цикл ген-ра имп.	10 - 90%
*Memorie • Программная память	18
*Bi-level OE-H 1M- . 2	SI / YES